

NPN SWITCHING SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/251

Devices

2N2218	2N2219
2N2218A	2N2219A
2N2218AL	2N2219AL

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N2218 2N2219	2N2218A; L 2N2219A; L	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	50	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	75	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	800		mAdc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$	0.8	W
		@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$	3.0	W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T_{op}, T_{stg}	-55 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	59	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

- 1) Derate linearly 4.6 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_A > +25^{\circ}\text{C}$
 2) Derate linearly 17.0 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



TO- 39* (TO-205AD)
2N2218, 2N2218A
2N2219, 2N2219A



TO-5*
2N2218AL,
2N2219AL

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_E = 10 \text{ mAdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L	$V_{(BR)CEO}$	30 50	Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 6.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 4.0 \text{ Vdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L All Types	I_{EBO}	10 10 10	μAdc ηAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 30 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 50 \text{ Vdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L	I_{CES}	10 10	ηAdc

2N2218; A; AL; 2N2219; A; AL JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Base Cutoff Current				
$V_{CB} = 50$ Vdc 2N2218; 2N2219	I_{CBO}		10	η Adc
$V_{CB} = 60$ Vdc 2N2218A; L; 2N2219A; L			10	
$V_{CB} = 60$ Vdc 2N2218; 2N2219			10	μ Adc
$V_{CB} = 75$ Vdc 2N2218A; L; 2N2219A; L			10	

ON CHARACTERISTICS (3)

Forward-Current Transfer Ratio					
$I_C = 0.1$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc	2N2218 2N2219 2N2218A; 2N2218AL 2N2219A; 2N2219AL	h_{FE}	20 35 30 50		
$I_C = 1.0$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc	2N2218 2N2219 2N2218A; 2N2218AL 2N2219A; 2N2219AL		25 50 35 75	150 325 150 325	
$I_C = 10$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc	2N2218 2N2219 2N2218A; 2N2218AL 2N2219A; 2N2219AL		35 75 40 100		
$I_C = 150$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc	2N2218; A; 2N2218AL 2N2219; A; 2N2219AL		40 100	120 300	
$I_C = 500$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc	2N2218; A; 2N2218AL 2N2219; A; 2N2219AL		20 30		
Collector-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150$ mAdc, $I_B = 15$ mAdc	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L		$V_{CE(sat)}$		0.4 0.3
$I_C = 500$ mAdc, $I_B = 50$ mAdc	2N2218; 2N2219 2N2218; L; 2N2219A; L				1.6 1.0
Base-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150$ mAdc, $I_B = 15$ mAdc	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A, L		$V_{BE(sat)}$	0.6 0.6	1.3 1.2
$I_C = 500$ mAdc, $I_B = 50$ mAdc	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L				2.6 2.0

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 20$ mAdc, $V_{CE} = 20$ Vdc, $f = 100$ MHz	$ h_{fe} $	2.5	12	
Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc, $f = 1.0$ kHz	h_{fe}	25 50 35 75		
Output Capacitance $V_{CB} = 10$ Vdc, $I_E = 0$, 100 kHz $\leq f \leq 1.0$ MHz	C_{obo}		8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5$ Vdc, $I_C = 0$, 100 kHz $\leq f \leq 1.0$ MHz	C_{ibo}		25	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

$V_{CC} = 30$ Vdc; $I_C = 150$ mAdc; $I_{B1} = 15$ mAdc

Turn-On Time (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/251)	2N2218, 2N2219 2N2218A, L, 2N2219A, L	t_{on}	40 35	η s
Turn-Off Time (See Figure 4 of MIL-PRF-19500/251)	2N2218, 2N2219 2N2218A, L, 2N2219A, L	t_{off}	250 300	η s

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μ s, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.